

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

24.05.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

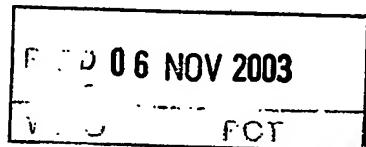
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 2月 19日

出願番号
Application Number: 特願 2003-041921

[ST. 10/C]: [JP 2003-041921]

出願人
Applicant(s): TDK株式会社
独立行政法人産業技術総合研究所
パイオニア株式会社
日本サムスン株式会社
シャープ株式会社

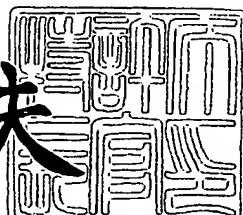


**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年10月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 2003P004
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G11B 7/00
【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
【氏名】 菊川 隆
【発明者】
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内
【氏名】 富永 淳二
【発明者】
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内
【氏名】 島 隆之
【発明者】
【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式会社総合研究所内
【氏名】 橋 昭弘
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
【氏名】 藤 寛
【発明者】
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 三星電子株式会社内
【氏名】 金 朱鎬

【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 301021533

【氏名又は名称】 独立行政法人産業技術総合研究所

【特許出願人】

【識別番号】 000005016

【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082865

【弁理士】

【氏名又は名称】 石井 陽一

【電話番号】 3839-0367

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-183498

【出願日】 平成14年 6月24日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007146

【納付金額】 15,750円

【その他】 国等以外のすべての者の持分の割合 75／100

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【フルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光記録／再生方法および光記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光記録媒体に対し、記録レーザービームを照射して記録マーク列を形成することにより記録を行い、開口数NAの光学系を用いて波長 λ の再生レーザービームを照射して記録マーク列を読み出すことにより再生を行う方法であって、

光記録媒体は、貴金属酸化物を含有する貴金属酸化物層を有し、

記録マーク列は、貴金属酸化物の分解によって貴金属酸化物層が変形することにより形成されたものであり、マーク長が $0.37\lambda/NA$ 未満である記録マークを少なくとも含み、

記録マーク列が形成されている貴金属酸化物層において貴金属粒子を不可逆的に析出させ、析出した貴金属粒子に再生レーザービームを照射することにより記録マーク列を読み出す光記録／再生方法。

【請求項 2】 貵金属酸化物層に銀酸化物、白金酸化物およびパラジウム酸化物の少なくとも 1 種が含有される請求項 1 の光記録／再生方法。

【請求項 3】 光記録媒体が、貴金属酸化物層を挟むように第 1 誘電体層および第 2 誘電体層を有する請求項 1 または 2 の光記録／再生方法。

【請求項 4】 光記録媒体が金属および／または半金属を主成分とする光吸収層を有し、光吸収層と貴金属酸化物層とが第 2 誘電体層を挟むように存在する請求項 3 の光記録／再生方法。

【請求項 5】 光吸収層が少なくとも Sb および／または Te を含有する請求項 4 の光記録／再生方法。

【請求項 6】 光記録媒体が第 3 誘電体層を有し、第 3 誘電体層と第 2 誘電体層とが光吸収層を挟むように存在する請求項 4 または 5 の光記録／再生方法。

【請求項 7】 光記録媒体が金属および／または半金属を主成分とする反射層を有し、反射層と光吸収層とが第 3 誘電体層を挟むように存在する請求項 6 の光記録／再生方法。

【請求項 8】 貴金属酸化物を含有する貴金属酸化物層を有し、前記貴金属

酸化物が白金酸化物および／またはパラジウム酸化物である光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光の回折によって決定される解像限界近傍およびこの解像限界よりも小さい寸法をもつ記録マークの記録および再生が可能な光記録／再生方法と、光記録媒体とに関する。

【0002】

【従来の技術】

通常、レーザービームを用いた再生方法では、光の回折によって決定される解像限界が存在する。この解像限界は、レーザービームの波長 λ とレンズの開口数 NA とによって決定される。カットオフ空間周波数は $2 \text{ NA} / \lambda$ なので、記録マークの長さと、隣接する 2 つの記録マーク間にあるスペースの長さと同じである記録マーク列は、その空間周波数が $2 \text{ NA} / \lambda$ (ラインペア/nm) 以下であれば読み取り可能である。この場合、読み取り可能な空間周波数に対応するマーク長 (=スペース長) は、

$$\lambda / 4 \text{ NA} = 0.25 \lambda / \text{NA}$$

となる。すなわち、配列ピッチ $0.5 \lambda / \text{NA}$ 未満、マーク長 $0.25 \lambda / \text{NA}$ 未満の記録マーク列を読み出して再生信号を得ることはできない。したがって、高密度に記録された信号を読み出すためには、 λ を小さくする、および／または、NA を大きくすることが有効であり、これらに関して多くの技術的検討が行われている。

【0003】

一方、解像限界をより小さくしようとする検討とは別に、解像限界より小さい記録マークを読み出すための技術として、様々な超解像再生技術が提案されている。超解像再生技術としては、たとえば、レーザー照射によって開口等を生じる機能を有する層を媒体内に設けることによって、媒体内で実質的に NA を高める技術が提案されている。

【0004】

また、たとえば非特許文献1 (Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 39 (2000) pp. 980-981) には、近接場光を利用した超解像技術が記載されている。この文献に記載されている光ディスクは、近接場光を用いて記録および再生が行われる。この光ディスクは、記録／再生光入射側から、ポリカーボネート基板、厚さ170nmのZnS-SiO₂層、厚さ15nmのAgO_x層（読み出し層）、厚さ40nmのZnS-SiO₂層、厚さ15nmのGe₂Sb₂Te₅層（記録層）および厚さ20nmのZnS-SiO₂層をこの順で積層した構造をもつ。この光ディスクにおける記録層は、相変化材料であるGe₂Sb₂Te₅からなる。そのためこの光ディスクでは、非晶質の記録層に結晶質記録マークを形成することになる。

【0005】

上記文献では、解像限界より小さい記録マークを記録し、記録後にAgO_x層にレーザービームを照射することによって、AgO_xをAgとO₂とに分解してAgプローブを生成し、このAgプローブの周囲に近接場光を発生させることにより、記録マークを読み出している。再生後にレーザービームが移動すると、AgおよびO₂は再びAgO_xに戻る。すなわち、Agプローブの生成は可逆的である。実際にこの技術を用いることにより、レーザー波長λ = 635nm、開口数NA = 0.60の光学系（解像限界ピッチ530nm、解像限界マーク長265nm）を用い、マーク長200nmのマーク列の読み出しに成功している。このときの読み出しパワーは2.5mWであり、線速度は6.0m/sである。しかし、この超解像再生技術では、信号強度の尺度の一つであるcarrier to noise ratio (CNR) が小さく実用レベルではない。また、読み出し層にプローブを生成するための読み出しパワーが比較的大きいため、読み出し用のレーザービームの照射によって記録層の非マーク部のアモルファス相が結晶化しやすい。そのため、繰り返し読み出しにより記録マークが劣化する、すなわち再生耐久性が十分ではない、という問題を抱えている。

【0006】

【非特許文献1】

Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 39 (2000) pp. 980-981

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、光の回折によって決定される解像限界より小さい記録マーク、または、解像限界以上ではあるが解像限界に近い寸法をもつ記録マークを含む記録マーク列を記録／再生する際に、含まれる全ての記録マークにおいて高い再生出力が得られ、かつ、高い再生耐久性を実現することである。

【0008】**【課題を解決するための手段】**

上記目的は下記（1）～（8）の本発明によって達成される。

（1） 光記録媒体に対し、記録レーザービームを照射して記録マーク列を形成することにより記録を行い、開口数NAの光学系を用いて波長 λ の再生レーザービームを照射して記録マーク列を読み出すことにより再生を行う方法であって、

光記録媒体は、貴金属酸化物を含有する貴金属酸化物層を有し、

記録マーク列は、貴金属酸化物の分解によって貴金属酸化物層が変形することにより形成されたものであり、マーク長が $0.37\lambda/NA$ 未満である記録マークを少なくとも含み、

記録マーク列が形成されている貴金属酸化物層において貴金属粒子を不可逆的に析出させ、析出した貴金属粒子に再生レーザービームを照射することにより記録マーク列を読み出す光記録／再生方法。

（2） 貴金属酸化物層に銀酸化物、白金酸化物およびパラジウム酸化物の少なくとも1種が含有される上記（1）の光記録／再生方法。

（3） 光記録媒体が、貴金属酸化物層を挟むように第1誘電体層および第2誘電体層を有する上記（1）または（2）の光記録／再生方法。

（4） 光記録媒体が金属および／または半金属を主成分とする光吸収層を有し、光吸収層と貴金属酸化物層とが第2誘電体層を挟むように存在する上記（3）の光記録／再生方法。

（5） 光吸収層が少なくともSbおよび／またはTeを含有する上記（4）の光記録／再生方法。

（6） 光記録媒体が第3誘電体層を有し、第3誘電体層と第2誘電体層とが

光吸收層を挟むように存在する上記（4）または（5）の光記録／再生方法。

（7） 光記録媒体が金属および／または半金属を主成分とする反射層を有し、反射層と光吸收層とが第3誘電体層を挟むように存在する上記（6）の光記録／再生方法。

（8） 貴金属酸化物を含有する貴金属酸化物層を有し、前記貴金属酸化物が白金酸化物および／またはパラジウム酸化物である光記録媒体。

【0009】

【発明の実施の形態】

本発明の発明者らは、貴金属酸化物層を有する媒体において、貴金属酸化物層を記録層として用い、この層に解像限界より小さい微小な記録マークまたは解像限界より大きいが解像限界に近い微小な記録マークを記録し、閾値以上の再生パワーで再生を行うことによって、超解像再生において高いCNRが得られ、かつ、高い再生耐久性が得られることを見いだした。

【0010】

図1（A）に、本発明の記録／再生方法が適用される光記録媒体の好ましい構成例を示す。この光記録媒体は、基板（図示せず）上に、第1誘電体層31、貴金属酸化物層4、第2誘電体層32、光吸收層5および第3誘電体層33をこの順で設けたものである。貴金属酸化物層4は AgO_x （ $x = 1$ ）から構成し、光吸收層5は $Ag-In-Sb-Te$ 合金から構成し、誘電体層31、32、33は $ZnS-SiO_2$ から構成してある。記録／再生のためのレーザービームは、基板を通して貴金属酸化物層4および光吸收層5に照射される。

【0011】

この媒体の特定の記録トラックに対し、開口数NA=0.60の光学系を用いて波長 $\lambda = 635\text{nm}$ の記録レーザービームを照射することにより、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列を記録した。記録レーザービームは、記録パワーレベル（10mW）およびバイアスパワーレベル（1mW）の2種のパワーレベルをもつように強度変調したものである。すなわち、記録パワーは10mWとした。次いで、再生パワー P_r を1mWまたは4mWとして再生を行い、CNRを測定した。その結果、再生パワー1mWではCNRが得られなかつたが、再生パ

ワー4mWで41dBという高いCNRが得られた。この場合、解像限界ピッチが530nm、解像限界マーク長が265nmなので、本発明により、超解像再生において従来にない高CNRが得られたことがわかる。

【0012】

図14 (A) に示す媒体は、貴金属酸化物層4をPtO_y (y = 2) から構成したほかは図1 (A) に示す媒体と同じ構成である。この媒体に対し、記録パワー・レベルを10.5mWに変更したほかは図1 (A) に示す媒体と同条件で記録を行い、CNRを測定した。その結果、再生パワー1mWではCNRが得られなかつたが、再生パワー4mWで40dB以上のCNRが得られた。

【0013】

再生パワー1mWで再生した後の図1 (A) に示す媒体について、断面の透過型電子顕微鏡 (TEM) 写真を図1 (B) に示す。また、再生パワー4mWで再生し、次いで、再生パワーを1mWとして再び再生した後のこの媒体について、断面のTEM写真を図1 (C) に示す。また、再生パワー1mWで再生した後の図14 (A) に示す媒体について、断面の透過型電子顕微鏡 (TEM) 写真を図14 (B) に示す。また、再生パワー4mWで再生し、次いで、再生パワーを1mWとして再び再生した後のこの媒体について、断面のTEM写真を図14 (C) に示す。これら各図に示す断面は、記録トラックとほぼ平行、すなわち記録マーク列とほぼ平行である。

【0014】

図1 (B) から、記録前にAgO_x層が存在していた領域に、記録ビーム照射により空洞が形成されたこと、この空洞の断面形状が周期的に変動しており、その変動周期が記録マークの配列ピッチの400nmに対応していること、が明瞭に見て取れる。したがって、図1 (B) の空洞断面において、凸部 (空洞の高さが相対的に大きい領域) が記録パワー・レベルのレーザービームを照射した領域 (記録マーク) に対応し、凹部 (空洞の高さが相対的に小さい領域) がバイアスパワー・レベルのレーザービームを照射した領域 (スペース) に対応すると考えられる。また、空洞内には、Ag粒子がわずかに析出している。また、光吸收層5は、記録前は非晶質であったが、記録後は、記録したトラックの全域で結晶化し

ていた。

【0015】

図1 (C) から、4mWのパワーで再生した後には、記録時に形成された空洞の輪郭に変化は認められないが、空洞中のAg粒子40が顕著に増えていることがわかる。すなわち、再生レーザービーム照射により、Ag粒子の析出が生じたことがわかる。なお、空洞中においてAg粒子40は均一に分布しているわけではないが、分布の不均一さによる再生信号の欠落は認められなかった。

【0016】

一方、図14 (B) および図14 (C) から、貴金属酸化物層4をPtO_yから構成した場合にも、貴金属酸化物層4内に記録マークに対応する空洞が形成されることがわかる。また、この場合、スペースに相当する領域には実質的に空洞が形成されず、図1 (B) のAgO_x層に比べ、記録マークに相当する空洞の外形がより明瞭となっていることがわかる。さらに、図14 (B) および図14 (C) から、PtO_y層では、記録時に空洞内に析出したPt粒子41は、4mWの高パワーで再生しても、形態、粒径、析出密度がほとんど変化しないことがわかる。

【0017】

以上の結果から、まず記録メカニズムの考察を行う。AgO_xからなる貴金属酸化物層4では、記録時（記録パワーレベルのレーザービームを照射時）にAgO_x→Ag+x/2O₂の分解と光吸収層5の結晶化とが起こる。記録時に発生した酸素ガス(O₂)は、貴金属酸化物層4内で体積膨張を起こして貴金属酸化物層4を変形させるとともに第2誘電体層32と光吸収層5とを押し上げる。また、PtO_yからなる貴金属酸化物層4においても、同様な分解が生じる。その結果、記録パワーレベルのレーザービームを照射した部位では、第2誘電体層32が図中の上方に突き出すように湾曲すると共に、その周囲に比べ光吸収層5の厚さが薄くなり、これによりこの部位は記録マークとして機能することになる。形成された空洞内にはO₂が封入されていると考えられる。このメカニズムが働くためには、貴金属酸化物が貴金属とO₂とに分解すること、分解によって発生したO₂が貴金属酸化物層4を変形させること、すなわち第2誘電体層32と光

吸収層5も変形させること、の2つのプロセスが必要となる。記録の際に、典型的な相変化記録材料からなる光吸収層5が全面的に結晶化を起こしていることから、この記録メカニズムは、結晶質と非晶質との反射率の違いに基づいて記録マークを検出する相変化型記録媒体における記録メカニズムとは異なる。

【0018】

次に、再生メカニズムの考察を行う。図1 (C) から、超解像再生によりAg粒子40が多量に析出することが明らかとなった。記録時に AgO_x から $Ag + x/2O_2$ への分解によって生成したAgは、図1 (B) に示されるように、一部が凝集してAg粒子40となる。図1 (B) からは確認できないが、凝集しなかったAgは、超微粒子の形で空洞の壁面に付着していると考えられる。この状態において、ある程度以上のパワーをもつ再生レーザービームを照射すると、Agの超微粒子が凝集し、TEMによって観察可能な程度の大きさのAg粒子が析出する。そして、このAg粒子が、近接場光を散乱するプローブとなり、前記Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 39 (2000) pp. 980-981に記載されたAgプローブと同様に機能して近接場光を伝搬光に変換し、超解像再生を可能にするものと考えられる。

【0019】

図1 (B) および図1 (C) では、マーク長およびスペース長とともに200 nmと短いため、マークでのO₂発生による貴金属酸化物4の変形がスペースにも影響を及ぼした結果、スペースに相当する領域も空洞となっている。しかし、より長いマーク長およびより長いスペース長をもつ記録マーク列を記録したところ、スペースにおいて貴金属酸化物4内に空洞は形成されず、また、マークにおいて空洞の高さは一定であった。

【0020】

本発明では、再生時のレーザービーム照射によって貴金属酸化物層4の空洞内にいったん析出した貴金属粒子は、再生後においても消失することはない。したがって、2回目以降の再生に際してさらに貴金属粒子を析出させる必要はない。ただし、4mWのパワーで再生して図1 (C) に示される状態となった後、再生パワーを1mWまで低下させたところ、CNRが得られなくなったので、2回目以降の再生に際しても、超解像再生が可能となる強度のレーザービームを照射する必

要がある。

【0021】

なお、貴金属粒子の析出は、再生レーザービームの照射によって行う必要はなく、再生前に、貴金属粒子析出のためにレーザービームを照射しておいてもよい。

【0022】

また、図1 (B) および図1 (C) に示す例では、記録時に貴金属粒子がわずかに析出しているが、記録時における貴金属粒子の析出量はさらに多くてもよい。たとえば、図14 (B) および図14 (C) に示されるように、記録時に貴金属粒子が多量に析出して、再生時など、その後のレーザービーム照射時には貴金属粒子の析出密度がほとんど変化しなくてもよい。また、記録時に析出した貴金属粒子の結晶構造や粒径が、再生時など、その後のレーザービーム照射時に変化してもよい。

【0023】

記録時および超解像再生時には、貴金属酸化物層4を透過したレーザービームが光吸收層5に照射されるように、レーザービーム入射方向を設定することが好ましい。金属および／または半金属からなる光吸收層5を通してレーザービームを貴金属酸化物層4に照射する場合、光吸收層5による反射および吸収を考慮して、レーザービームのパワーを高くする必要があり、光吸收層5が破損するおそれがある。また、光吸收層5が相変化材料から形成される場合、貴金属酸化物層4を透過させずに光吸收層5に直接レーザービームを照射すると、貴金属酸化物層4に記録マークが形成されずに光吸收層5に非晶質または結晶質からなる記録マークが形成されることがある。その場合、本発明が特徴とする記録／再生メカニズムが実現しなくなる。

【0024】

なお、本発明は、媒体が光吸收層5を有しない場合も包含する。その場合、記録時および再生時のいずれにおいても、レーザービームは媒体のどちらの面から入射させてもよい。

【0025】

ところで、特許第3157019号公報および特許第3071243号公報には、酸化銀からなる記録層を有し、記録ビーム照射により酸化銀がAgとO₂とに分解されて記録層中に空隙が形成される光記録媒体が記載されている。これらの光記録媒体は、記録時に酸化銀層中に空隙が形成される点で本発明が適用される媒体と類似する。しかし、これらの公報では、解像限界付近の寸法をもつ微小な記録マークの再生について全く着目しておらず、また、これらの公報の実施例では、再生レーザービームとして波長780nm、パワー0.5mWのものを用いているが、この程度の再生パワーではAg粒子を析出させることはできないため、超解像再生は不可能である。

【0026】

光記録媒体に情報を記録する際には、E FM等のデータ変調方式によって変調された信号に基づいてレーザービーム強度を変調して媒体に照射し、様々な長さの記録マークを含む記録マーク列を記録トラックに形成する。本発明は、解像限界である0.25λ/NAより小さい記録マークを再生する際に高CNRが得られるという優れた効果を示す。また、解像限界より大きいが解像限界に近い微小な記録マークを再生する際にも、CNR向上効果が実現する。CNR向上効果が大きいのは、マーク長が0.37λ/NA未満、特に0.28λ/NA以下である記録マークを再生するときである。したがって本発明は、このような寸法の記録マークを含む記録マーク列を形成する場合に有効である。

【0027】

なお、マーク長が著しく短いと、本発明によっても高CNRを得ることが困難となるため、本発明は、マーク長が0.05λ/NA以上、特に0.09λ/NA以上の記録マークを含む記録マーク列の再生に適用することが好ましい。

【0028】

本発明では、記録時に、貴金属酸化物を分解して貴金属酸化物層中に空洞を形成し、再生前または少なくとも初回の再生時に、貴金属粒子を不可逆的に析出させる必要がある。記録パワーおよび/または再生パワーが低すぎると、このような記録/再生メカニズムが十分に働かなくなり、高CNRが得られない。一方、記録パワーおよび/または再生パワーが高すぎると、媒体の耐久性に影響を与える

、媒体が損傷することがある。したがって、記録パワーおよび再生パワーには、最適値が存在する。

【0029】

ただし、短波長のレーザービームを開口数の大きい光学系で照射すると、ビームスポット内のエネルギー密度が高くなるので、波長および開口数が異なる条件では、レーザービームのパワーが同じであってもそれが記録時および再生時に貴金属酸化物層に与える影響は異なる。また、貴金属酸化物層や光吸收層など、媒体を構成する各層の構成材料や厚さが異なる場合、レーザービームのパワーが同じであってもそれが記録時および再生時に貴金属酸化物層に与える影響は異なる。

【0030】

したがって、本発明において記録パワーおよび再生パワーは、高CNRが得られるように実験的に決定すればよい。なお、本発明では、好ましくは25dB以上、より好ましくは40dB以上のCNRが得られることが望ましい。

【0031】

以下、本発明の記録／再生方法が適用される媒体について、詳細に説明する。

【0032】

図2に示す媒体構造

本発明の光記録媒体の構成例を図2に示す。この媒体は、基板2上に、第1誘電体層31、貴金属酸化物層4、第2誘電体層32、光吸收層5および第3誘電体層33をこの順で有する。

【0033】

貴金属酸化物層4

記録前の媒体において、貴金属酸化物層4は貴金属酸化物を含有し、好ましくは、実質的に貴金属酸化物だけから構成される。

【0034】

貴金属酸化物層には、2種以上の貴金属酸化物が含有されていてもよい。その場合、貴金属酸化物層は単層構造であってもよく、それぞれ少なくとも1種の貴金属酸化物を含有する層を複数積層した積層構造であってもよい。ただし、貴金

属酸化物層に2種以上の貴金属酸化物が含有される場合、記録時に2種以上の貴金属酸化物のすべてが同時に分解しないことがあり、また、再生時に2種以上の貴金属のすべてが同時に凝集しないことがあり、これらにより記録／再生特性が悪影響をうけることがある。したがって、貴金属酸化物層には貴金属酸化物が1種だけ含有されることが好ましい。

【0035】

本発明で用いる貴金属の種類は特に限定されず、前述した記録／再生メカニズムは、どの貴金属を用いた場合でも機能するが、酸化物の形成のしやすさ、酸化物の安定性、可視光による近接場光の発生効率の観点から、白金、銀およびパラジウムの少なくとも1種が好ましく、銀および／または白金がより好ましく、より高いCNRが得られ、かつ再生耐久性が高くなることから、特に白金が好ましい。

【0036】

白金酸化物を用いる場合、これをPtO_yで表したとき、微小な記録マークを再生する際に高いCNRを得るために、好ましくは

$$0.5 \leq y, \text{ より好ましくは}$$

$$1 \leq y$$

とする。ただし、yが大きいと、解像限界よりマーク長が大きい記録マークを再生する際のCNRが低くなってしまうため、様々な長さの記録マークを含む記録マーク列を再生する際に高い出力を得るために、好ましくは

$$y \leq 4, \text{ より好ましくは}$$

$$y < 3$$

である。また、PtO_yの組成は、再生耐久性にも関わる。解像限界より小さい記録マークの再生耐久性を十分なものとするためには、すなわち繰り返し再生によるCNR低下を抑えるためには、好ましくは

$$1 \leq y$$

とし、解像限界よりマーク長が大きい記録マークの再生耐久性を十分なものとするためには、好ましくは

$$2 < y$$

とする。

【0037】

銀酸化物を用いる場合、これを AgO_x で表したとき、微小な記録マークを再生する際に高い C N R を得るためにには、好ましくは

0. $5 \leq x \leq 1.5$ 、より好ましくは
0. $5 \leq x \leq 1$

である。 x が小さすぎると高 C N R が得られにくく、 x が大きすぎると AgO_x が不安定となるため、保存耐久性および再生耐久性が低くなりやすい。

【0038】

パラジウム酸化物を用いる場合、これを PdO_z で表したとき、微小な記録マークを再生する際に高い C N R を得るためにには、好ましくは

1. $0 \leq z \leq 1.5$

である。 z が小さすぎると高 C N R が得られにくい。一方、成膜プロセスの都合上、 z が 1.5 を超えるパラジウム酸化物膜を形成することは困難である。

【0039】

なお、貴金属酸化物層 4 の組成は、たとえば蛍光 X 線分析により測定することができる。

【0040】

貴金属酸化物層 4 の厚さは、好ましくは 1 ~ 30 nm、より好ましくは 2 ~ 20 nm である。貴金属酸化物層 4 が薄すぎると、連続膜とすることが困難となり、安定した記録／再生特性が得られにくい。一方、貴金属酸化物層 4 が厚すぎると、高い C N R が得られなくなる。

【0041】

なお、図 2 から光吸収層 5 を取り去った構造（図 5 に示す構造）も、本発明に包含される。この構造の媒体では、レーザービーム照射の際に貴金属酸化物層 4 が十分には昇温しにくく、その結果、十分に高い C N R が得られにくい。そのため、光吸収層 5 を設けない構造においては、貴金属酸化物層 4 を厚くして光吸収率を高めることが好ましい。この構造における貴金属酸化物層 4 の好ましい厚さは、20 ~ 100 nm である。この場合に貴金属酸化物層 4 が厚すぎると、貴金属

酸化物層4が不安定となって再生耐久性が低くなりやすい。

【0042】

貴金属酸化物層4の形成方法は特に限定されず、スパッタリング、蒸着などの物理的気相堆積法（PVD）や、化学的気相堆積法（CVD）を用いることができる。これらのうちでは、貴金属ターゲットを用い、酸素を反応ガスとして用いる反応性スパッタリング法が好ましい。

【0043】

光吸收層5

光吸收層5は、再生時にレーザービームを吸収して昇温することにより、隣り合う貴金属酸化物層4を昇温して貴金属析出を促進する。貴金属酸化物層4は、記録／再生用のレーザービームに対する透明性が高いため加熱されにくいで、光吸收層を設けないと十分に高いCNRを得ることが困難となる。

【0044】

光吸收層5は、レーザービーム照射により十分に昇温するように構成する。そのためには、光吸收層5を、吸収係数の高いものとしたり、熱伝導率の低いものとしたりすればよい。また、本発明では前述したメカニズムで空洞形成により記録マークを形成する必要があるため、空洞形成を妨げないように、光吸收層5を変形しやすいものとすることが好ましい。

【0045】

光吸收層5の構成材料としては、金属および半金属から選択された1種または2種以上の元素を含む金属または合金（金属間化合物が含まれる）を主成分とするものが好ましく、光吸收層5に要求される上記特性を実現しやすいことから、少なくともSbおよび／またはTeを含有する合金が好ましい。

【0046】

Sbおよび／またはTeを含有する合金の組成としては、

$$\text{式I } (\text{Sb}_a \text{Te}_{1-a})_{1-b} \text{M}_b$$

で表されるものが好ましい。上記式Iにおいて、元素MはSbおよびTeをそれぞれ除く元素を表し、aおよびbは原子比を表し、好ましくは

$$0 \leq a \leq 1, \quad 0 \leq b \leq 1$$

$0 \leq b \leq 0.25$

である。元素Mの含有量を表すbが大きすぎると、光吸收層に要求される前記特性が不十分となりやすい。元素Mは特に限定されないが、たとえばIn、Ag、Au、Bi、Se、Al、P、Ge、H、Si、C、V、W、Ta、Zn、Ti、Sn、Pb、Pdおよび希土類元素(Sc、Yおよびランタノイド)から選択される少なくとも1種が好ましい。

【0047】

なお、上記式Iで表される組成をもつ合金には、相変化記録材料として知られている合金が含まれる。相変化記録材料は、結晶質時の反射率と非晶質時の反射率との相違を利用して、非晶質または結晶質からなる記録マークを読み出す媒体の記録材料として使われる合金である。ただし、本発明における光吸收層5は、結晶質時の反射率と非晶質時の反射率との相違を利用する相変化型記録層としては使用されない。

【0048】

光吸收層5が相変化記録材料からなり、かつ、非晶質である場合において、貴金属酸化物層4に短い記録マークだけを記録する際には、記録時に光吸收層5面内への熱拡散により、光吸收層5は記録トラック方向に連続的に結晶化される、すなわちマーク間(スペース)においても光吸收層5は結晶化されるため、再生時に問題は生じない。しかし、貴金属酸化物層4に長いスペースを形成する際には、スペース中央付近において光吸收層5が非晶質のまま残ることがある。非晶質のまま残った領域は、再生時に結晶化することができ、この結晶化により再生信号に乱れが生じることがある。

【0049】

光吸收層5が非晶質である場合に生じるこのような再生信号の乱れを防ぐためには、貴金属酸化物層4に記録する前に、光吸收層5の全域を結晶化しておくことが好ましい。この結晶化は、相変化型媒体における記録層の全面結晶化(初期化)と同様に、レーザービーム照射によって行うことができる。ただし、光吸收層5の結晶化処理に際しては、貴金属酸化物層4において貴金属酸化物の分解が生じないように処理条件を設定する必要がある。

【0050】

光吸收層5の厚さは、薄すぎると十分な光吸收率を確保することが困難となり、厚すぎると記録時に変型しにくくなるため、好ましくは2～200nm、より好ましくは10～100nmとする。

【0051】

光吸收層5の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

【0052】**誘電体層31、32、33**

第1誘電体層31は、記録／再生時に貴金属酸化物層4から伝わる熱を面内方向に逃がすことにより基板2を保護するために、また、媒体の反射率を制御するために設けられる。第2誘電体層32は、CNR向上および貴金属酸化物層4の保護のために設けられる。第3誘電体層33は、光吸收層5を保護するために設けられる。第2誘電体層32は、記録時に貴金属酸化物層4での空洞形成に伴って変形する必要があるため、変形しやすい構成とすることが好ましい。

【0053】

各誘電体層の厚さは、その機能が十分に発揮されるように適宜決定すればよいが、通常、第1誘電体層31は10～300nm、第2誘電体層32は5nm以上100nm未満、好ましくは10～60nm、第3誘電体層33は10～200nmであることが好ましい。第2誘電体層32が厚すぎても薄すぎても、超解像再生時のCNRが低くなってしまう。

【0054】

各誘電体層に用いる誘電体としては、例えば、Si、Ge、Zn、Al、希土類元素などから選択される少なくとも1種の金属成分または半金属成分を含む各種化合物が好ましい。化合物としては、酸化物、窒化物または硫化物が好ましく、これらの化合物の2種以上を含有する混合物を用いることもできる。ただし、第2誘電体層32を変形しやすくするためには、窒化ケイ素をはじめとする窒化物は好ましくない。

【0055】

なお、第3誘電体層33上に、媒体の保護を目的として樹脂製の保護層を設けてもよい。また、光吸收層5が相変化材料から構成される場合には第3誘電体層33を設けることが好ましいが、第3誘電体層33を設けることは必須ではなく、光吸收層5に接して樹脂保護層を形成してもよい。

【0056】

これらの誘電体層の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

【0057】

基板2

基板2は、媒体の剛性を維持するために設けられる。基板2の厚さは、通常、0.2～1.2mm、好ましくは0.4～1.2mmとすればよい。基板2には、通常、トラッキングのためのグループ（案内溝）を設ける。

【0058】

なお、本発明では、第1誘電体層31から第3誘電体層33までの各層を、図2に示す積層順とは逆に基板上に積層してもよい。

【0059】

基板2側からレーザービームを媒体に入射させる場合には、透光性材料から基板2を構成する。基板2の構成材料は、必要とされる剛性や透明性などに応じ、樹脂、ガラス、金属、セラミック等の各種材料から選択すればよい。

【0060】

図3に示す媒体構造

図3に示す媒体は、図2に示す媒体の第3誘電体層33上に、反射層6を設けた構造である。反射層6を設ける場合、記録／再生用のレーザービームは、図中の下側から媒体に入射させる。

【0061】

反射層6を設けることにより、解像限界より大きなマーク長をもつ記録マークの再生出力を向上させることができる。反射層6を設けない構造では、光吸收層5と第3誘電体層33との界面を通過した光はすべて媒体の外側へ透過する。そのため、近接場光を使わずに伝搬光の反射を検出することにより読み出される記

録マーク、すなわち、超解像再生ではなく通常再生が可能な寸法の記録マークでは、CNRが大きくならない。これに対し、反射層6を設ければ、第3誘電体層33と反射層6との界面で反射した光とその他の界面で反射した光との干渉効果が利用できるようになるので、伝搬光だけで再生することのできる大きさの記録マークのCNRが増大するものと考えられる。

【0062】

ただし、反射層6を厚くすると、反射層6で反射して光ピックアップに戻る伝搬光の強度が高くなる結果、貴金属酸化物層4において近接場光から変換されて光ピックアップに戻る伝搬光の強度が相対的に低くなるため、超解像再生の対象となる微小な記録マークのCNRが低くなってしまう。したがって、反射層6の厚さは、大きな記録マークおよび微小な記録マークの双方において十分なCNRが得られるように設定することが好ましい。具体的には、反射層6構成材料に応じて実験的に決定すればよいが、通常、1～100nm、特に2～15nmとすることが好ましい。

【0063】

反射層6は、Al、Au、Ag、Pt、Cu、Ni、Cr、Ti、Si等の金属または半金属の単体や、金属または半金属を2種以上含有する合金から構成すればよい。

【0064】

反射層6の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

【0065】

図4に示す媒体構造

図4に示す媒体は、図2に示す媒体の第1誘電体層31と貴金属酸化物層4との間に、析出促進層7を設けた構造である。

【0066】

貴金属酸化物層4に接触する層の材料に依存して、再生時の貴金属粒子の析出温度が変化する。一方、再生耐久性の観点からは、超解像再生のための再生パワーは低いほど好ましい。そのため、貴金属酸化物層4に接して、貴金属粒子の析

出温度を低下させる機能をもつ層を設けることが好ましい。この層は、媒体のトータルな光学的設計や熱的バランスを損なわない程度の厚さとすることが好ましい。析出促進層7は、このように再生感度を向上させる機能をもつ層であり、これを設けることにより、設けない場合に比べてより低い再生パワーで同等のCNRが得られるようになる。

【0067】

析出促進層7は、たとえば窒化ケイ素から構成し、厚さは2～20nmとすることが好ましい。

【0068】

析出促進層7の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

【0069】

なお、図3に示す反射層6と図4に示す析出促進層7とを、ともに設けてもよい。

【0070】

図5に示す媒体構造

図5に示す媒体は、図2に示す媒体から光吸收層5および第3誘電体層33を取り去った構造である。

【0071】

この構造の媒体でも、超解像再生は可能であり、また、再生耐久性は良好である。ただし、高いCNRを得ることは困難である。

【0072】

【実施例】

以下の実施例において、光ディスクサンプルの評価には、開口数NA=0.60の光学系から波長 $\lambda=635\text{nm}$ のレーザービームを射出する低分解能ピックアップ（解像限界ピッチ530nm、解像限界マーク長265nm）と、開口数NA=0.65の光学系から波長 $\lambda=405\text{nm}$ のレーザービームを射出する高分解能ピックアップ（解像限界ピッチ312nm、解像限界マーク長156nm）とが対向して搭載してある光ディスク評価装置（パルステック社製DDU1000）を用い

た。記録および再生の際の線速度は6m/sとした。

【0073】

この評価装置では、低分解能ピックアップから出射されたレーザービームは、基板側から貴金属酸化物層4に入射し、高分解能ピックアップから出射されたレーザービームは、基板とは反対側から貴金属酸化物層4に入射する。そのため、この評価装置では、貴金属酸化物層4に記録された記録マーク列を、分解能の異なる2つのピックアップでそれぞれ再生することが可能である。たとえば、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列の再生は、 $\lambda = 635\text{nm}$ 、NA=0.60の低分解能ピックアップでは超解像再生に相当し、 $\lambda = 405\text{nm}$ 、NA=0.65の高分解能ピックアップでは通常再生に相当する。

【0074】

したがって、両方のピックアップにおいてCNRが得られないことは、読み取り可能な記録マークが形成されなかったことを意味する。また、繰り返し再生に伴ってCNRが低下することは、繰り返し再生に伴って記録マークが消滅したことを意味する。また、高分解能ピックアップでは通常再生が可能で、低分解能ピックアップでは超解像再生が必要な寸法の記録マークを再生する際に、低分解能ピックアップを用いた超解像条件でのみCNRが得られないことは、記録マークは存在しているが超解像再生メカニズムが働いていないことを意味する。

【0075】

なお、以下の実施例では、特に断りのない限り、記録は低分解能ピックアップにより行った。

【0076】

実施例1-1 (図2の構造：貴金属酸化物A_gO_x)

図2に示すように、基板2／第1誘電体層31／貴金属酸化物層4／第2誘電体層32／光吸收層5／第3誘電体層33からなる積層構造を有する光ディスクサンプルを形成した。各層の組成および厚さは、ポリカーボネート基板(0.6mm)／ZnS-SiO₂(130nm)／A_gO_x(18nm)／ZnS-SiO₂(40nm)／Ag-In-Sb-Te(60nm)／ZnS-SiO₂(100nm)とした。かっこ内は厚さである。ZnS-SiO₂層は、モル比で表した組成が

(ZnS) 85 (SiO₂) 15であるターゲットをAr雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。AgO_x層は、Ar/O₂=10 sccm/10 sccmの流量比の混合ガス雰囲気中でAgターゲットをスパッタリングすることにより形成した。形成されたAgO_xにおけるxは1であった。Ag-In-Sb-Te層は、Ag 6.0 In 4.5 Sb 60.8 Te 28.7 (モル%) ターゲットをAr雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。

【0077】

サンプル形成後、サンプルを線速度6m/sで回転させながら、記録対象トラックに対し、低分解能ピックアップにより1.2mWのパワーのレーザービームを3秒間連続照射することにより、光吸収層5を結晶化させた。なお、特に断りのない限り、以下の実施例においてもこの実施例と同様にして、記録/再生特性を評価する前に光吸収層5を結晶化させた。

【0078】

このサンプルに、記録パワー10mWで、配列ピッチ200nm~1.6μm (マーク長100~800nm) の記録マーク列をそれぞれ記録した後、低分解能ピックアップを用いて再生パワーP_r=1mWまたは4mWで再生し、CNRを測定した。結果を図6に示す。

【0079】

図6から、マーク長400nm未満 (0.37λ/NA未満) の記録マークからなる記録マーク列を再生する際に、再生パワーを4mWとすることにより特異的にCNRが増大していることがわかる。特に、マーク長200nmの記録マークからなるマーク列では、41dBという高いCNRが得られている。

【0080】

なお、光吸収層5の組成 (モル比) をGe₂Sb₂Te₅または(Sb_{0.7}Te_{0.3})_{0.95}Ge_{0.05}とした場合でも、ほぼ同様な結果が得られた。

【0081】

前記した図1 (B) および図1 (C) にそれぞれ示すTEM写真は、この実施例と同条件で記録/再生を行った実験におけるサンプル断面写真である。ただし、その実験に際しては、記録前に光吸収層5は結晶化させなかった。

【0082】

比較例1 (図2の構造：光吸收層5への相変化型記録)

実施例1-1と同様にしてサンプルを作製した。ただし、光吸收層5は結晶化させなかった。

【0083】

このサンプルに対し、高分解能ピックアップを用いて第3誘電体層33側からレーザービームを入射させて、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列を記録パワー6mWで記録し、高分解能ピックアップを用いて0.7mWのパワーで再生したところ、44dBのCNRが得られた。

【0084】

次に、低分解能ピックアップを用いて4mWのパワーで連続的に再生したところ、初期には22dBのCNRが得られたが、数秒以内に信号が完全に消滅した。その後、高分解能ピックアップを用いて0.7mWのパワーで再生したところ、CNRは得られなかった。

【0085】

4mWのパワーのレーザービームを連続的に照射したときに記録マーク列が消滅したことから、この比較例では、非晶質の光吸收層5に結晶質記録マークが形成される相変化型記録がなされていると考えられ、この記録マーク列に対し、低分解能ピックアップで貴金属酸化物層4にAg粒子を析出させながら超解像再生を行ったものと考えられる。すなわち、この比較例における記録／再生方法は、相変化型記録を行っている点で、前記Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 39 (2000) pp. 980-981に記載されている方法に近い。この比較例1と上記実施例1-1との比較から明らかなように、相変化型記録を行った場合には、得られるCNRが低くかつ再生耐久性も劣る。

【0086】

実施例1-2 (図2の構造：貴金属酸化物PtO_y)

実施例1-1における貴金属酸化物層4をPtO_y(4nm)に替えたサンプルを作製した。PtO_y層は、PtターゲットをAr/O₂=5sccm/5sccmの流量比の混合ガス雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。PtO_yにお

けるyは2であった。

【0087】

このサンプルについて、記録パワー14mWで、配列ピッチ160nm～1.6μm（マーク長80～800nm）のマーク列をそれぞれ記録し、低分解能ピックアップを用いて再生パワー $P_r = 1$ mWまたは4mWで再生した。結果を図7に示す。

【0088】

図7において、再生パワー $P_r = 1$ mWのとき、マーク長が400nm（0.37λ/NA）より小さくなるとCNRが急激に減少し、解像限界より小さい200nmのマークではCNRが得られていない。これに対し、再生パワー $P_r = 4$ mWでは、超解像再生が必要な微小な記録マークであっても、十分に高いCNRが得られている。具体的には、マーク長150nm以上の全ての記録マークで、40dB以上のCNRが得られている。

【0089】

AgO_x を用いた図6と PtO_y を用いた図7とを比較すると、超解像再生が可能な再生パワー $P_r = 4$ mWのとき、全てのマーク長において図7のほうがCNRが高いことがわかる。したがって、貴金属酸化物層4を構成する貴金属酸化物としては白金酸化物が望ましい。

【0090】

前記した図14（A）、図14（B）および図14（C）にそれぞれ示すTEM写真は、この実施例と同条件で記録／再生を行った実験におけるサンプル断面写真である。ただし、その実験に際しては、記録前に光吸收層5は結晶化させなかった。

【0091】

実施例1-3（図2の構造：貴金属酸化物 PdO_z ）

実施例1-1における貴金属酸化物層4を PdO_z （4nm）に替えたサンプルを作製した。 PdO_z 層は、 Pd ターゲットを $Ar/O_2 = 5\text{ sccm}/5\text{ sccm}$ の流量比の混合ガス雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。 PdO_z におけるzは1.10であった。

【0092】

このサンプルについて、高分解能ピックアップと同一の光学系を用いて、基板側から記録パワー 11mW で、配列ピッチ $100\sim800\text{nm}$ (マーク長 $50\sim400\text{nm}$) のマーク列をそれぞれ記録し、高分解能ピックアップを用いて、基板側から再生パワー $P_r = 1\text{mW}$ または 4mW で再生した。結果を図15に示す。

【0093】

図15において、再生パワー $P_r = 1\text{mW}$ のとき、マーク長が 200nm より小さくなると C N R が急激に減少し、解像限界より小さい 150nm のマークでは C N R がほとんど得られていない。これに対し、再生パワー $P_r = 4\text{mW}$ では、超解像再生が必要な微小な記録マークであっても、十分に高い C N R が得られている。具体的には、マーク長 100nm 以上の全ての記録マークで、 35dB 以上の C N R が得られている。

【0094】

なお、同一のサンプルについて低分解能ピックアップを用いて記録再生を行ったところ、記録パワー 12mW 、再生パワー $P_r = 4\text{mW}$ の条件で、解像限界よりも小さい 200nm のマークで 42dB の C N R が得られた。

【0095】

実施例1-4 (図2の構造: PtO_y 層の酸素含有量による比較)

実施例1-2の構造において、 PtO_y 層形成に際し流量比 A_r/O_2 を制御して、 y の相異なる PtO_y 層を有する複数のサンプルを作製した。各サンプルにおける y の値と流量 (単位: sccm) の比とは、

$$y = 0 \quad : A_r/O_2 = 10/0,$$

$$y = 0.75 : A_r/O_2 = 7.5/2.5,$$

$$y = 2 : A_r/O_2 = 5.0/5.0,$$

$$y = 3 : A_r/O_2 = 2.5/7.5$$

である。これらのサンプルに対し、各々の最適記録パワーで、配列ピッチ $160\text{nm}\sim1.6\mu\text{m}$ (マーク長 $80\sim800\text{nm}$) の記録マーク列をそれぞれ記録し、低分解能ピックアップを用いて 4mW の再生パワーで再生した。結果を図8に示す。

【0096】

また、図9および図10に、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列および配列ピッチ1.6μm（マーク長800nm）の記録マーク列を繰り返し再生したときのCNRの変化をそれぞれ示す。図9および図10から、様々な長さの記録マークにおいて良好な再生耐久性を得るためにには、yを大きくしたほうがよいことがわかる。

【0097】

実施例1-5（図2の構造：PdO_z層の酸素含有量による比較）

実施例1-3の構造において、PdO_z層形成に際し流量比Ar/O₂を制御して、zの相異なるPdO_z層を有する複数のサンプルを作製した。各サンプルにおけるzの値と流量（単位：sccm）の比とは、

$$y = 0.82 : Ar/O_2 = 8.5 / 1.5,$$

$$y = 1.10 : Ar/O_2 = 5.0 / 5.0,$$

$$y = 1.12 : Ar/O_2 = 1.0 / 9.0$$

である。これらのサンプルに対し、高分解能ピックアップを用いて、各々の最適記録パワーで、配列ピッチ200～600nm（マーク長100～300nm）の記録マーク列をそれぞれ記録し、高分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した。結果を図16に示す。

【0098】

図16から、解像限界よりも小さいマークで高いCNRを得るためにには、 $1.0 \leq z$ とすることが好ましいことがわかる。また、この結果からは、zの上限は特に限定されないが、成膜時に雰囲気ガス中における酸素の比率を著しく高くしても、 $1.5 < z$ となるようなパラジウム酸化物層を得ることは困難であることがわかった。

【0099】

実施例1-6（図2の構造：PtO_y層とAgO_x層との比較）

実施例1-1で作製したAgO_x層（x=1）を有するサンプルと、PtO_y層（y=3）の厚さを8nmとしたほかは実施例1-4と同様にして作製したサンプルとについて、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列および配列ピッチ1.6μm（マーク長800nm）の記録マーク列を、低分解能ピック

アップを用いて4mWの再生出力で繰り返し再生したときのCNRの変化を調べた。結果を図11に示す。

【0100】

図11から、貴金属酸化物層4としてPtO_y層を用いたサンプルにおいて、再生耐久性が大幅に向かうことがわかる。PtO_y層では、再生時に析出した貴金属粒子の形状および大きさが、高パワーで繰り返し再生を行っても変動しにくく安定であると考えられる。

【0101】

実施例1-7 (図2の構造：PtO_y層の膜厚による比較)

PtO_yからなる貴金属酸化物層4をy=3となる条件で形成し、その膜厚を4~30nmの範囲内で変更したほかは実施例1-4と同様にしてサンプルを作製した。これらのサンプルに、それぞれの最適条件で配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生し、CNRを測定した。各サンプルのPtO_y層の厚さとCNRとの関係は、「厚さ：CNR」の形で表して、

4nm: 4.4dB、

8nm: 4.1dB、

12nm: 3.0dB、

16nm: 2.9dB、

18nm: 2.8dB、

30nm: 2.7dB

であった。

【0102】

実施例1-8 (図2の構造：PdO_z層の膜厚による比較)

PdO_zからなる貴金属酸化物層4をz=1.10となる条件で形成し、その膜厚を2~15nmの範囲内で変更したほかは実施例1-5と同様にしてサンプルを作製した。これらのサンプルに、高分解能ピックアップを用いて、それぞれの最適条件で配列ピッチ300nm(マーク長150nm)の記録マーク列を記録し、高分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生し、CNRを測定した。

各サンプルの PdO_x 層の厚さと C N R との関係は、「厚さ：C N R」の形で表して、

2 nm : 2 6 dB、

4 nm : 3 5 dB、

10 nm : 3 2 dB、

15 nm : 2 6 dB

であった。

【0103】

実施例1-9 (図2の構造：光吸収層5の構成材料による比較)

光吸収層5を S i、A u または W で構成したほかは実施例1-1と同様にして作製したサンプルに、記録パワー 9 mW で配列ピッチ 4 0 0 nm (マーク長 2 0 0 nm) の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて 4 mW の再生パワーで再生したところ、光吸収層5構成材料と C N R との関係は、

S i : 1 9 dB、

A u : 2 0 dB、

W : 2 4 dB

であった。

【0104】

この結果は、光吸収層5構成材料として A u、S i または W を用いると、相変化材料を用いる場合に比べ超解像記録特性が悪くなることを示している。貴金属酸化物層4を構成する AgO_x それ自体は吸収係数が小さいため、この実施例における条件では昇温が不十分となり、記録時に分解しない。したがって、適切な光吸収層の存在が必要となる。光吸収層5を A u または S i で構成した場合に十分な特性が得られなかったのは、A u の場合は熱伝導率が高いので AgO_x 層に熱が伝わりにくかったためであると考えられ、S i の場合は S i の吸収係数が小さいため光吸収層として十分に機能しなかったためであると考えられる。Wを用いた場合は、光を吸収して昇温する層としては機能するが、Wは硬い材料であるため、記録時の貴金属酸化物層4における空洞形成を阻害したものと考えられる。

【0105】

実施例1-10 (図2の構造：第2誘電体層32の構成材料による比較)

第2誘電体層32を窒化ケイ素から構成したほかは実施例1-1と同様にして作製したサンプルについて、記録パワー14mWで、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、CNRは得られなかった。

【0106】

また、上記記録マーク列を高分解能ピックアップを用いて0.7mWの再生パワーを再生したところ、CNRは得られなかった。すなわち、通常再生も不可能であった。

【0107】

このように通常再生も不可能であることから、第2誘電体層32を窒化ケイ素から構成すると、読み取り可能な記録マークを形成できないことがわかる。窒化ケイ素は、実施例1-1で用いたZnS-SiO₂に比べてはるかに硬い材料であるため、AgO_xの分解により生成したO₂が、記録マークとして機能する空洞を貴金属酸化物層4中に形成できなかったためと考えられる。

【0108】

実施例1-11 (図2の構造：第2誘電体層32の膜厚による比較)

第2誘電体層32の膜厚を100nmとしたほかは実施例1-1と同様にしてサンプルを作製した。このサンプルに記録パワー11mWで、配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、CNRは得られなかった。

【0109】

また、上記記録マーク列を記録した直後および低分解能ピックアップにより4mWで再生した後のそれぞれにおいて、高分解能ピックアップを用いて0.7mWの再生パワーで再生したところ、いずれの場合も40dB以上のCNRが得られた。

【0110】

実施例2-1 (図3の構造：反射層6の効果)

実施例1-1で作製したサンプルの第3誘電体層33の上に、反射層6として

厚さ10nmのA g層またはA l層を形成することにより、図3に示す構造のサンプルを得た。A g層およびA l層は、それぞれA gターゲットおよびA lターゲットをAr雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。

【0111】

これらのサンプルについて、記録パワー10mWで、配列ピッチ400nm～1.6μm（マーク長200～800nm）の記録マーク列をそれぞれ形成し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した結果を、図12に示す。なお、図12には、反射層6を設けないサンプルの結果も示してある。

【0112】

図12から、反射層6を設けることにより、解像限界よりも大きな記録マークのCNRが増大することがわかる。

【0113】

実施例2-2（図3の構造：反射層6の膜厚による比較）

反射層6を図13に示す厚さとしたほかは実施例2-1と同様にしてサンプルを作製した。これらのサンプルについて、それぞれの最適記録パワーで配列ピッチ400nm（マーク長200nm）の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した結果を、図13に示す。

【0114】

図13から、反射層6の膜厚が厚くなるほど、超解像再生におけるCNRが低くなることがわかる。

【0115】

実施例3（図4の構造：析出促進層7の効果）

実施例1-1で作製したサンプルの第1誘電体層31と貴金属酸化物層4との間に、析出促進層7として厚さ5nmの窒化ケイ素層を形成することにより、図4に示す構造のサンプルを得た。窒化ケイ素層は、SiターゲットをAr/N₂=8/2の流量比の混合ガス雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。窒化ケイ素層の組成はSi₃N₄であった。

【0116】

このサンプルに記録パワー10mWで、配列ピッチ400nm（マーク長200nm

) の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて再生したところ、再生パワーが3mWのときに最大のCNR35dBが得られた。一方、実施例1-1で作製したサンプルでは、CNRが最大となる再生パワーは4mWだったので、析出促進層7を設けることにより、再生感度が向上したことがわかる。

【0117】

実施例4 (図5の構造：光吸收層5を設けない構造)

図5に示すように、基板2／第1誘電体層31／貴金属酸化物層4／第2誘電体層32からなる積層構造を有する光ディスクサンプルを形成した。このサンプルは、実施例1-1のサンプルから、光吸收層5および第3誘電体層33を取り去った構造である。ただし、貴金属酸化物層4の厚さは、18nmまたは60nmとした。

【0118】

貴金属酸化物層4の厚さが18nmであるサンプルに、5～14mWの記録パワーで、配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、CNRは得られなかった。一方、このサンプルに、14mWの記録パワーで、配列ピッチ1.6μm(マーク長800nm)の記録マーク列を記録し、4mWの再生パワーで再生したところ、34dBのCNRが得られた。

【0119】

また、貴金属酸化物層4の厚さが60nmであるサンプルに対し、7mWの記録パワーで、配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、12dBのCNRが得られた。一方、このサンプルに、7mWの記録パワーで、配列ピッチ1.6μm(マーク長800nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、33dBのCNRが得られた。

【0120】

この結果は、光吸收層5を設けなくても記録が可能であり、かつ通常再生が可能であることを示している。したがって、貴金属酸化物4自体が記録層として機能することがわかる。

【0121】

しかし、貴金属酸化物層4の厚さが18nmであるサンプルでは、400nmのピッチ（記録マーク長200nm）のマークの超解像再生が不可能であり、前記した再生メカニズムが働かなかったと考えられる。一方、貴金属酸化物層4の厚さが60nmのサンプルでは、CNRは低いが超解像再生が可能である。

【0122】

超解像再生においてCNRが得られない、あるいは低くなったのは、以下の理由によると考えられる。まず、通常再生が可能であることから、記録時には貴金属層4がレーザービームを吸収して昇温し、AgO_xがAgとO₂とに分解して記録マークが形成されたと考えられる。しかし、記録後には貴金属酸化物層4中にAgO_xがほとんど存在せず、媒体中にレーザービームの吸収を担う層がなくなってしまったため、再生用のレーザービームを照射しても貴金属酸化物層4の昇温が不十分となり、Ag粒子がほとんど析出しないか、十分には析出しなかったと考えられる。貴金属酸化物層4を厚くした場合に超解像再生が可能となったのは、貴金属酸化物層4の光吸収量が多くなったためと考えられる。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

(A)は、本発明の光記録媒体の構造を示す断面図である。(B)および(C)はそれぞれ薄膜構造を示す図面代用写真であって、(A)に示す媒体の断面の透過型電子顕微鏡写真であり、(B)は、記録後に1mWのパワーで再生した後の写真、(C)は、記録後に4mWのパワーで再生し、次いで1mWのパワーで再生した後の写真である。

【図2】

本発明の光記録媒体の構成例を示す断面図である。

【図3】

本発明の光記録媒体の他の構成例を示す断面図である。

【図4】

本発明の光記録媒体の他の構成例を示す断面図である。

【図5】

本発明の光記録媒体の他の構成例を示す断面図である。

【図6】

マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

【図7】

マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

【図8】

マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

【図9】

再生回数とCNRとの関係を示すグラフである。

【図10】

再生回数とCNRとの関係を示すグラフである。

【図11】

再生回数とCNRとの関係を示すグラフである。

【図12】

マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

【図13】

反射層の厚さとCNRとの関係を示すグラフである。

【図14】

(A) は、本発明の光記録媒体の構造を示す断面図である。(B) および(C) はそれぞれ薄膜構造を示す図面代用写真であって、(A) に示す媒体の断面の透過型電子顕微鏡写真であり、(B) は、記録後に1mWのパワーで再生した後の写真、(C) は、記録後に4mWのパワーで再生し、次いで1mWのパワーで再生した後の写真である。

【図15】

マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

【図16】

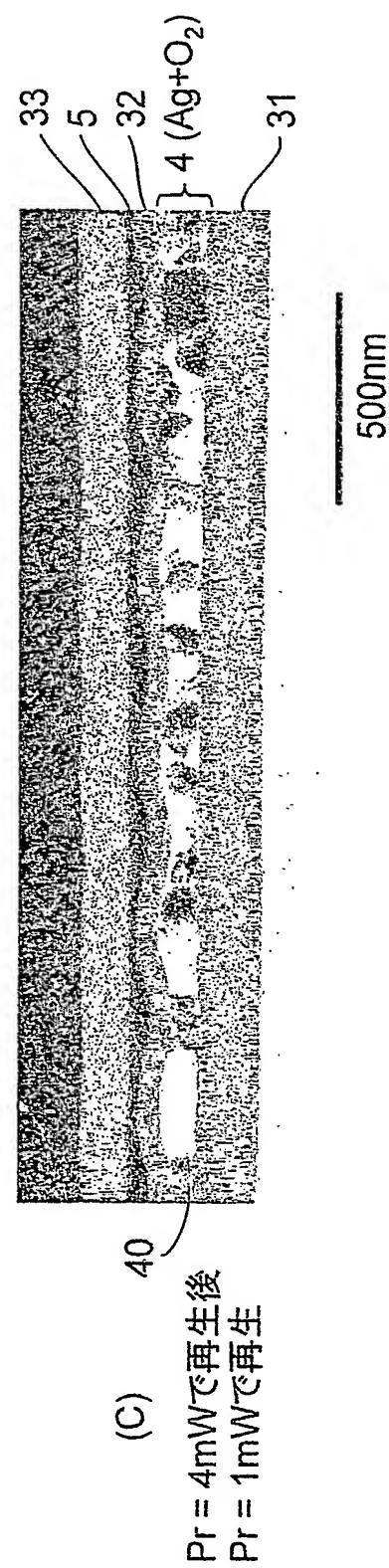
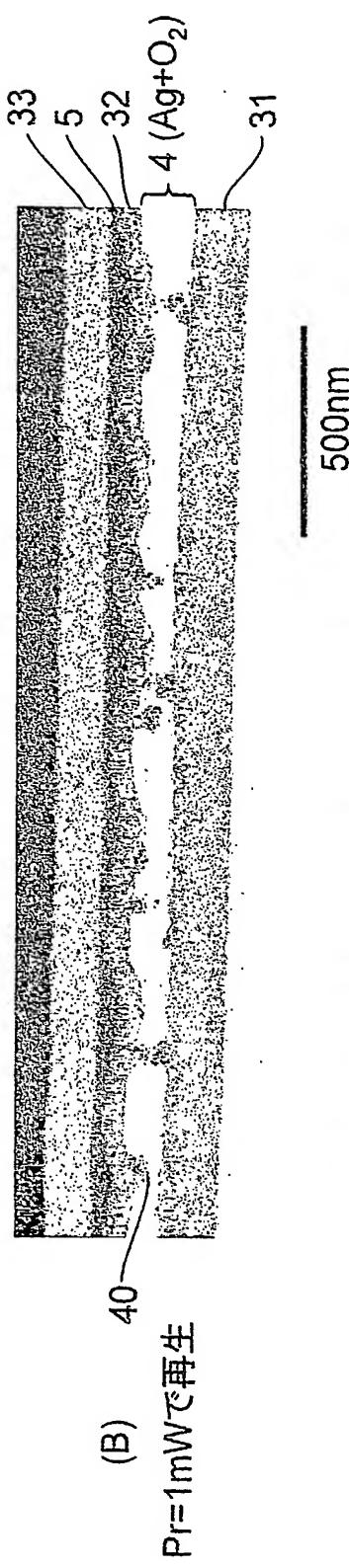
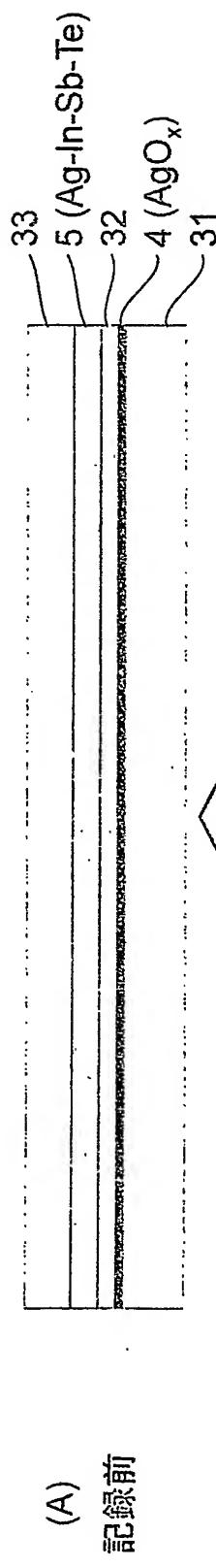
マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

【符号の説明】

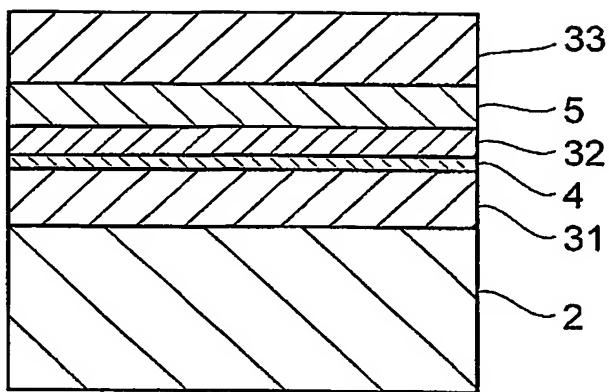
2 基板

- 3 1 第1誘電体層
- 3 2 第2誘電体層
- 3 3 第3誘電体層
- 4 貴金属酸化物層
- 4 0 析出した貴金属粒子 (A g 粒子)
- 4 1 析出した貴金属粒子 (P t 粒子)
- 5 光吸收層
- 6 反射層
- 7 析出促進層

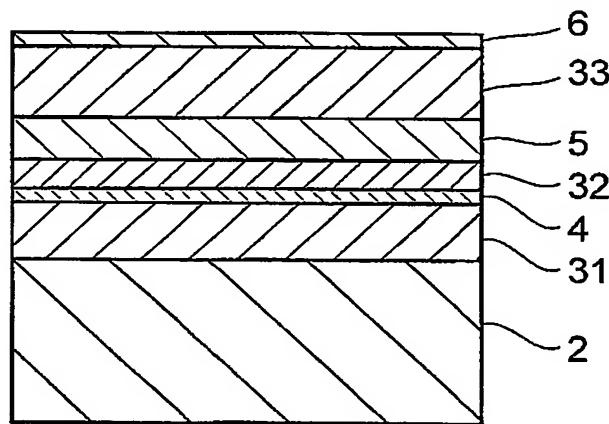
【書類名】 図面
【図1】



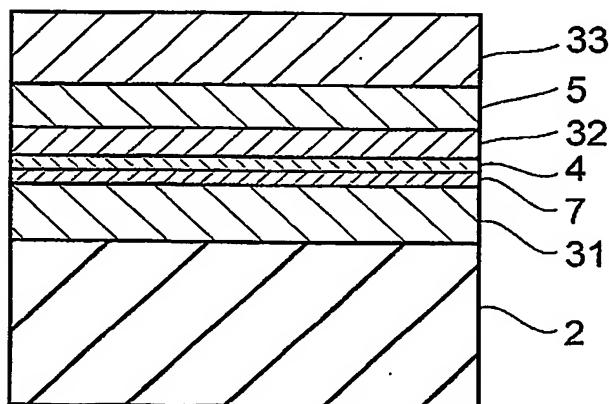
【図2】



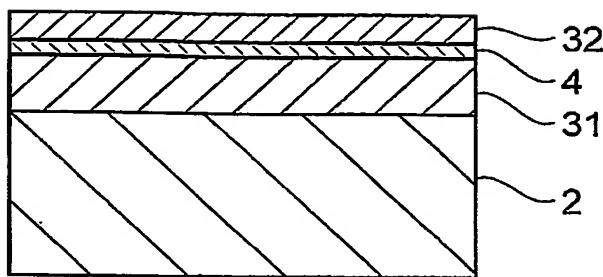
【図3】



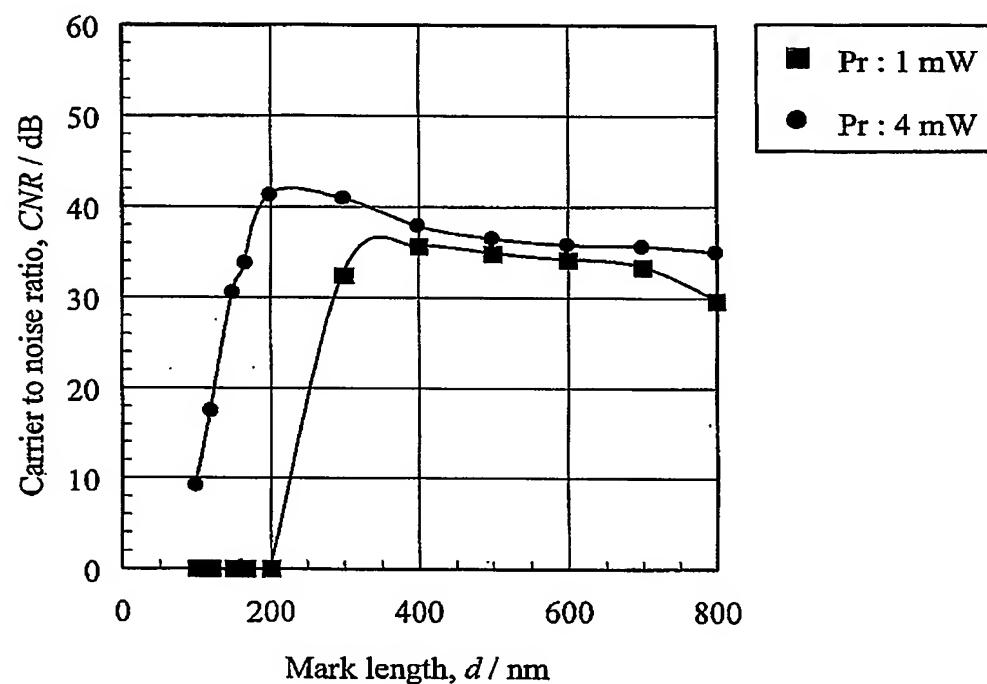
【図4】



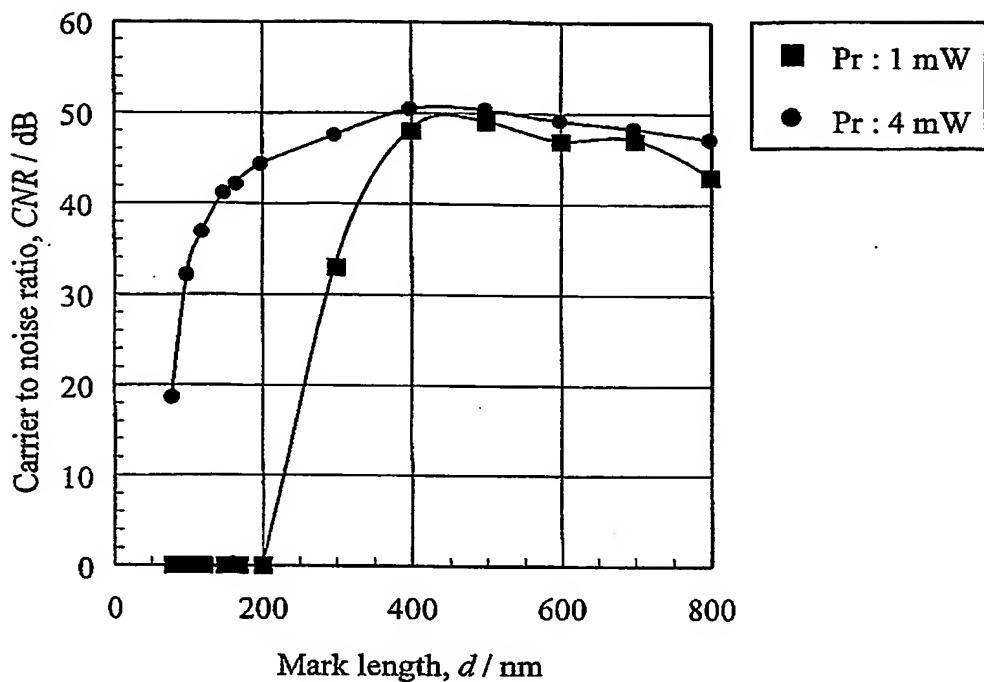
【図5】



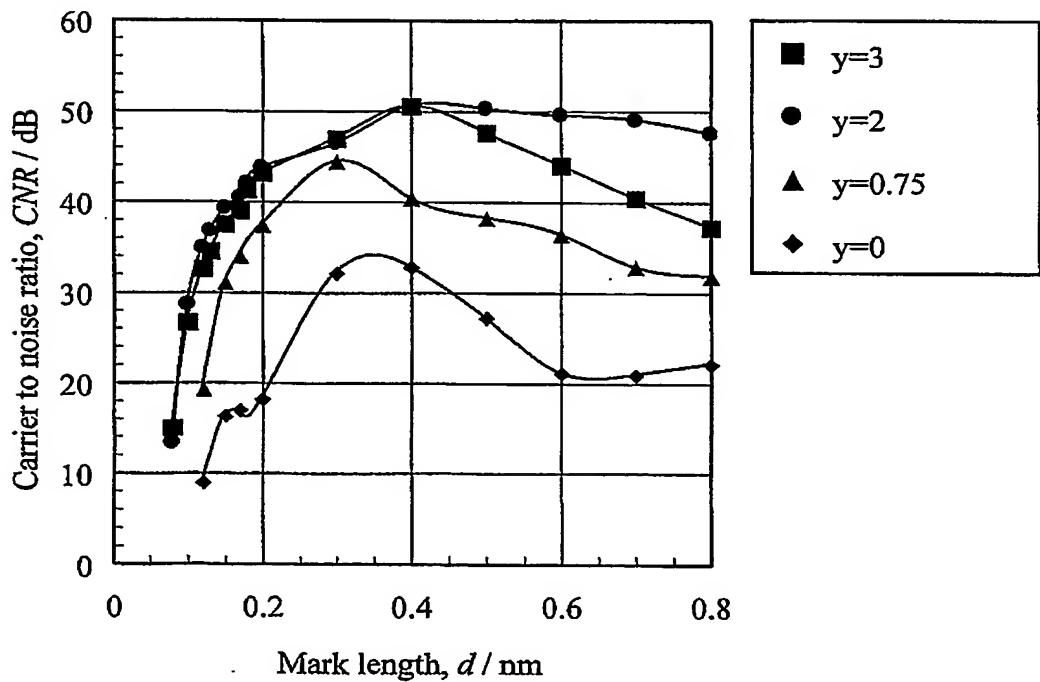
【図6】



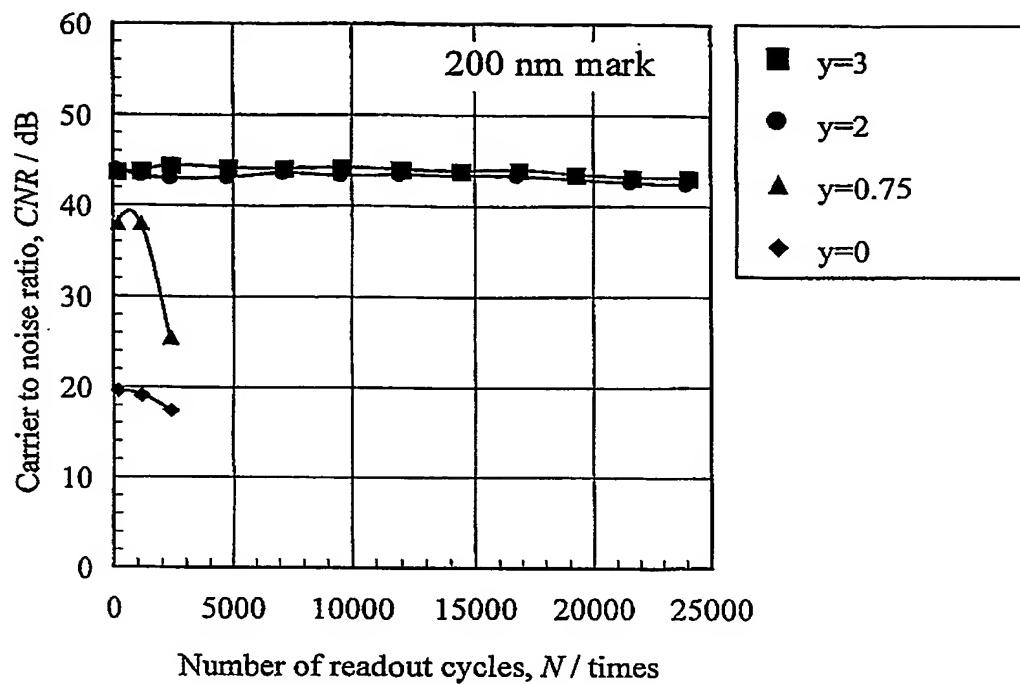
【図 7】



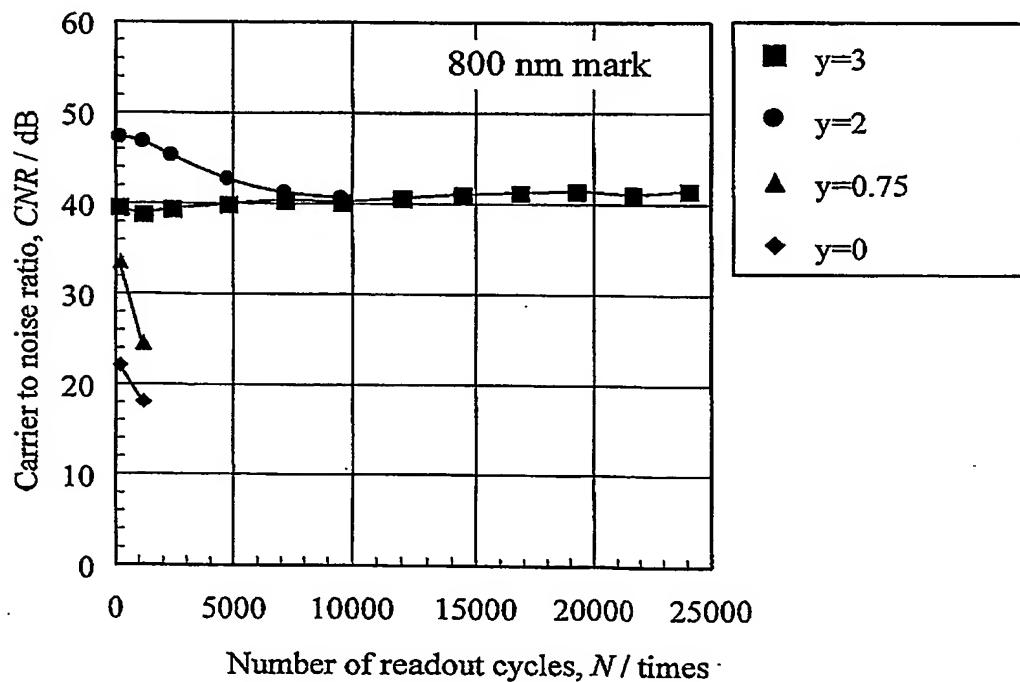
【図 8】



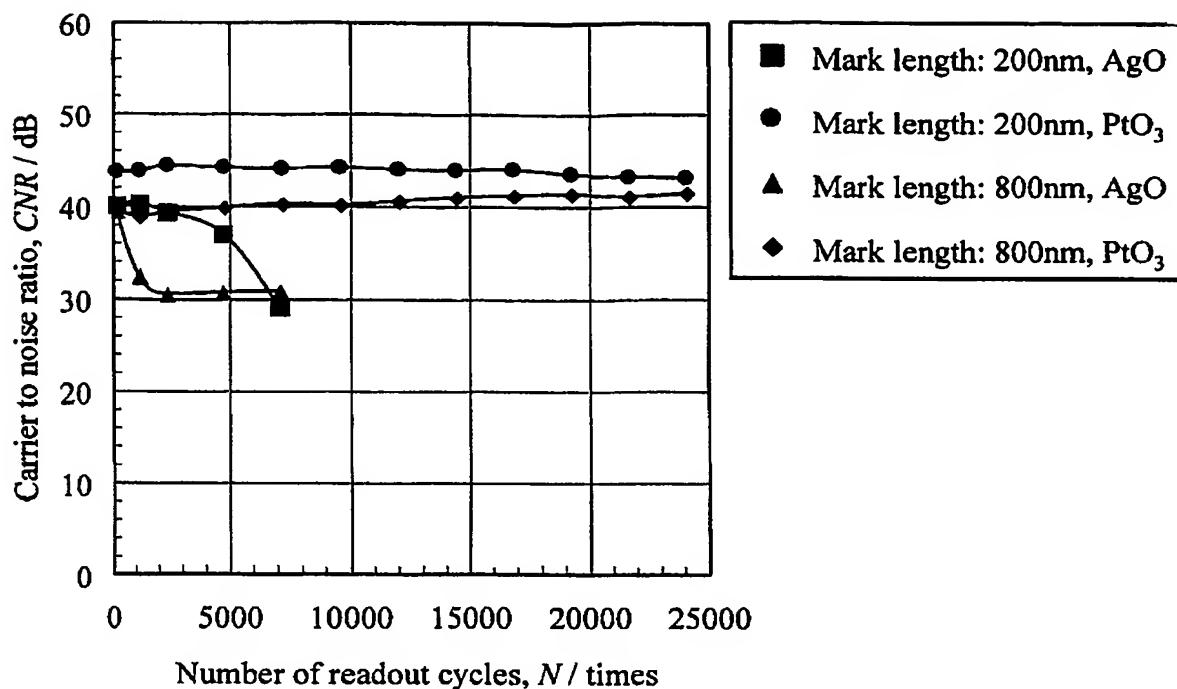
【図 9】



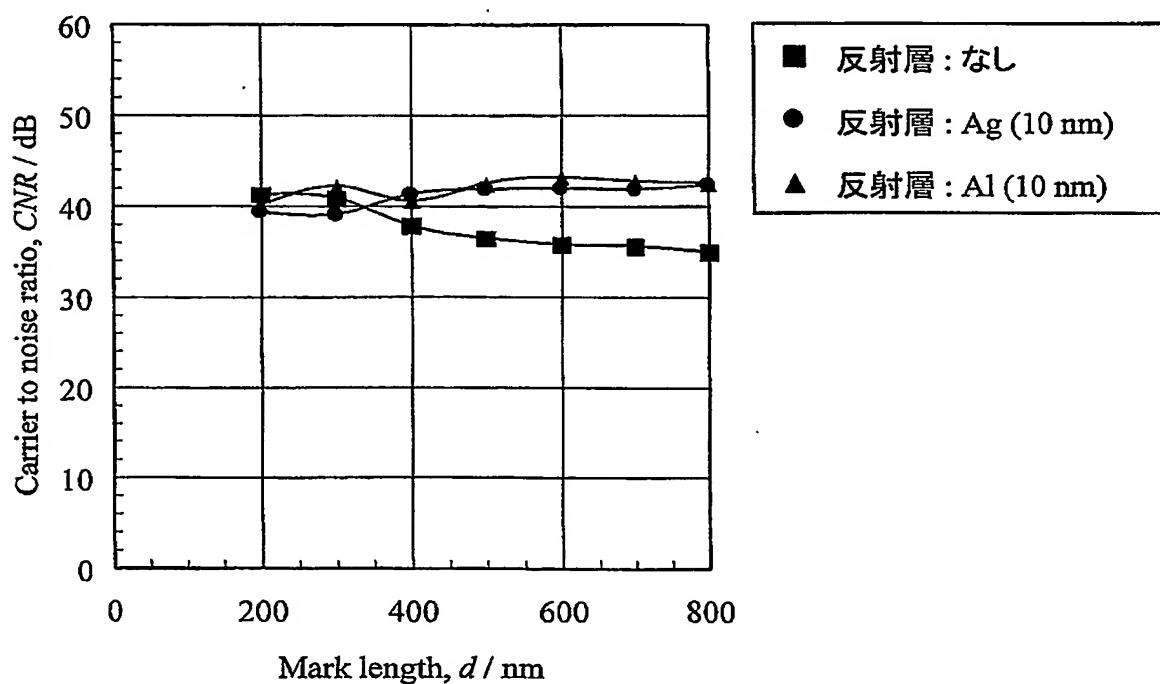
【図 10】



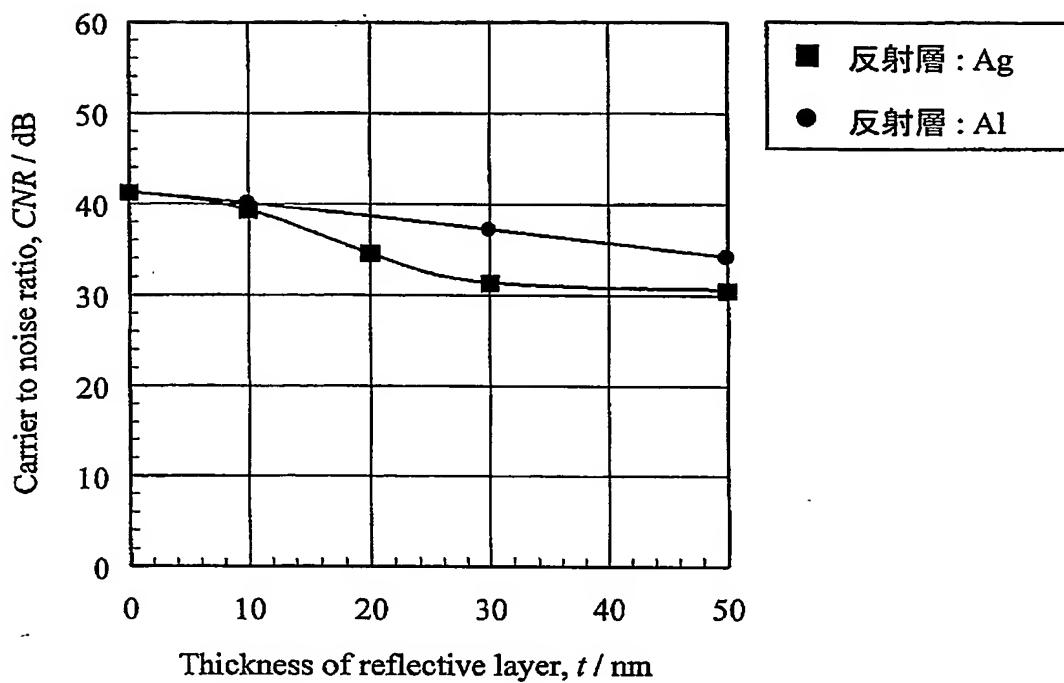
【図11】



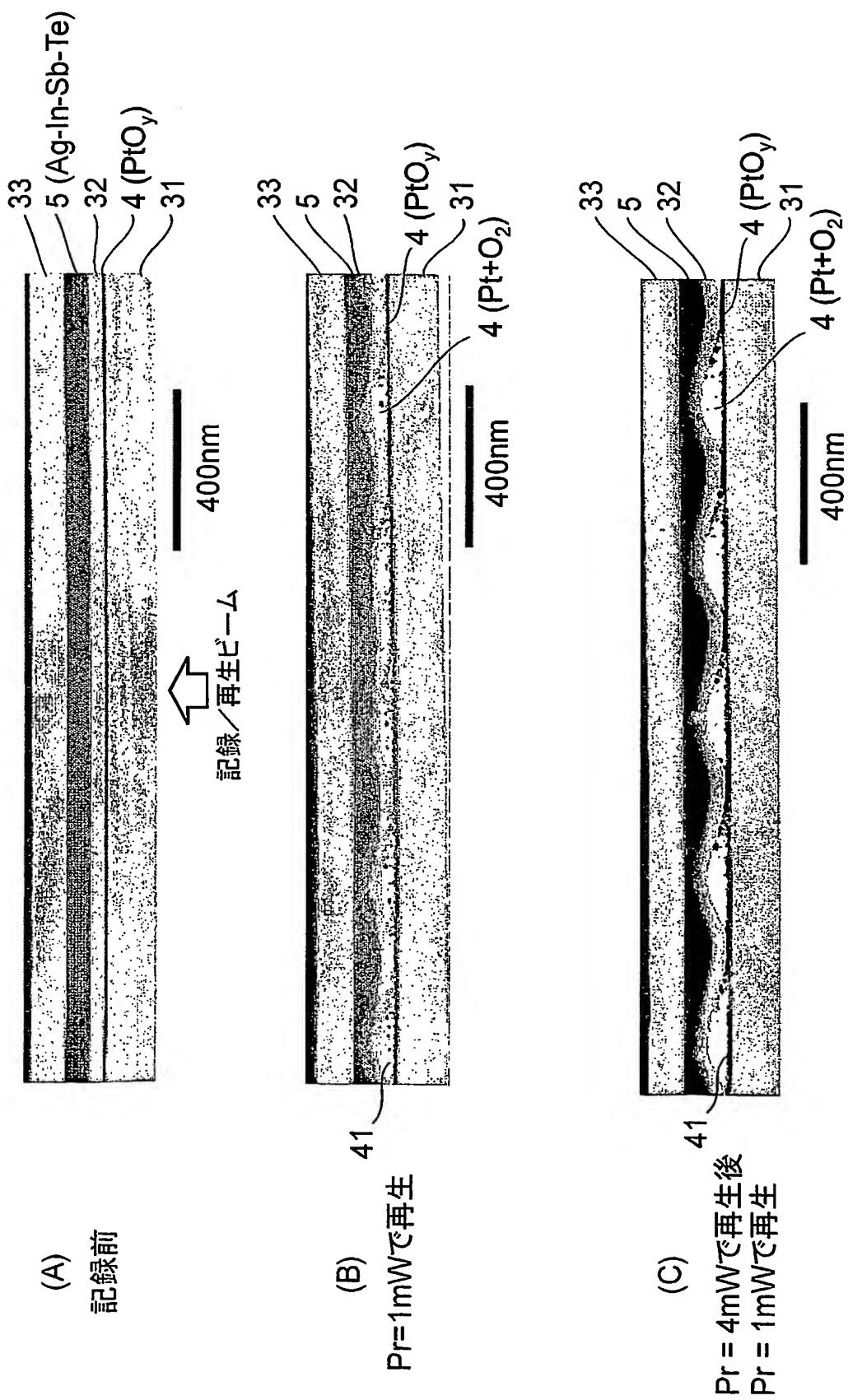
【図12】



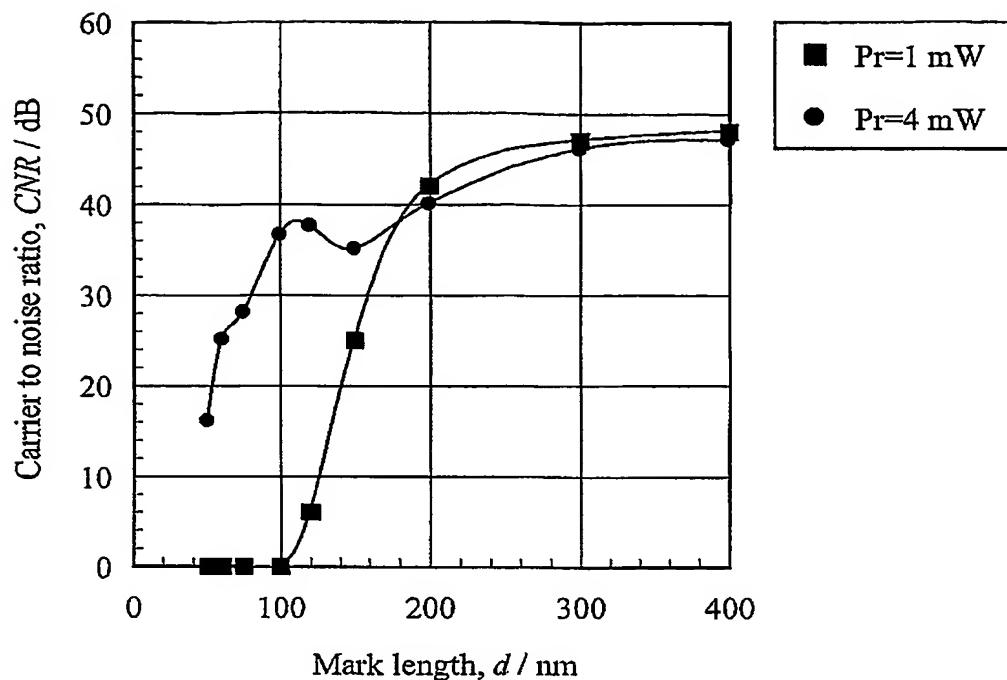
【図13】



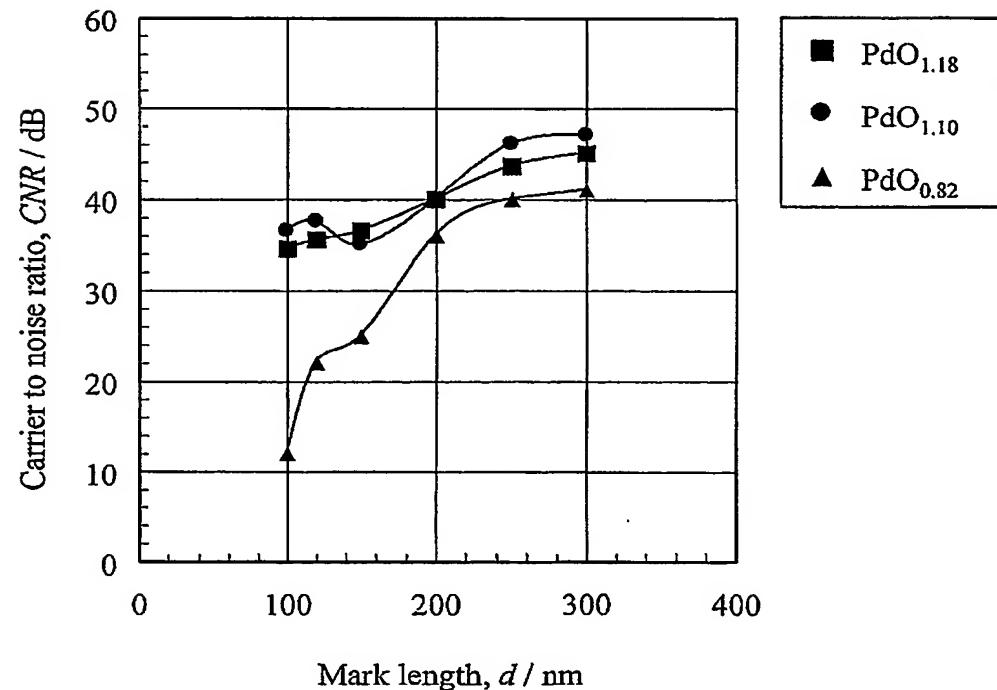
【図 14】



【図15】



【図16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 解像限界より小さい記録マーク、または、解像限界以上ではあるが解像限界に近い寸法をもつ記録マークを含む記録マーク列を記録／再生する際に、含まれる全ての記録マークにおいて高い再生出力が得られ、かつ、高い再生耐久性を実現する。

【解決手段】 貴金属酸化物層を有する光記録媒体に対し、貴金属酸化物の分解によって貴金属酸化物層を変形させることにより記録マーク列を形成する。記録マーク列が形成されている貴金属酸化物層において貴金属粒子を不可逆的に析出させ、析出した貴金属粒子に再生レーザービームを照射することにより記録マーク列を読み出す。再生レーザービームの波長を λ 、レーザービーム照射光学系の開口数をNAとしたとき、記録マーク列は、マーク長が $0.37\lambda/NA$ 未満である記録マークを少なくとも含む。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-041921
受付番号	50300267141
書類名	特許願
担当官	塩野 実 2151
作成日	平成15年10月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 2月19日
【特許出願人】	
【識別番号】	000003067
【住所又は居所】	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
【氏名又は名称】	T D K 株式会社
【特許出願人】	
【識別番号】	301021533
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関1-3-1
【氏名又は名称】	独立行政法人産業技術総合研究所
【特許出願人】	
【識別番号】	000005016
【住所又は居所】	東京都目黒区目黒1丁目4番1号
【氏名又は名称】	パイオニア株式会社
【特許出願人】	
【識別番号】	000005049
【住所又は居所】	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
【氏名又は名称】	シャープ株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100082865
【住所又は居所】	東京都文京区湯島3丁目23番1号 天神弥栄興 産ビル 石井特許事務所
【氏名又は名称】	石井 陽一

【書類名】 出願人名義変更届

【整理番号】 2003P004

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003- 41921

【承継人】

【持分】 010/100

【識別番号】 500356706

【氏名又は名称】 日本サムスン株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100082865

【弁理士】

【氏名又は名称】 石井 陽一

【電話番号】 3839-0367

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007146

【納付金額】 4,200円

【プルーフの要否】 要

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-041921
受付番号	50301042612
書類名	出願人名義変更届
担当官	塩野 実 2151
作成日	平成15年10月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 6月23日
【承継人】	
【識別番号】	500356706
【住所又は居所】	東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号 浜町センタービル
【氏名又は名称】	日本サムスン株式会社
【承継人代理人】	申請人
【識別番号】	100082865
【住所又は居所】	東京都文京区湯島3丁目23番1号 天神弥栄興産ビル 石井特許事務所
【氏名又は名称】	石井 陽一

【書類名】 手続補正書（方式）
【整理番号】 2003P004
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
 【出願番号】 特願2003- 41921
【補正をする者】
 【識別番号】 500356706
 【氏名又は名称】 日本サムスン株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100082865
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 石井 陽一
【手続補正】
 【補正対象書類名】 出願人名義変更届
 【補正対象項目名】 承継人
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【承継人】
 【識別番号】 500356706
 【氏名又は名称】 日本サムスン株式会社
【その他】 承継人の欄の持分を削除した。

特願 2003-041921

出願人履歴情報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 ティーディーケイ株式会社

2. 変更年月日 2003年 6月27日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 TDK株式会社

特願 2003-041921

出願人履歴情報

識別番号 [301021533]

1. 変更年月日 2001年 4月 2日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区霞が関 1-3-1
氏 名 独立行政法人産業技術総合研究所

特願2003-041921

出願人履歴情報

識別番号 [000005016]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

氏 名 パイオニア株式会社

特願 2003-041921

出願人履歴情報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏 名 シャープ株式会社

特願2003-041921

出願人履歴情報

識別番号 [500356706]

1. 変更年月日 2000年 7月25日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号 浜町センタービル
氏 名 日本サムスン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.